

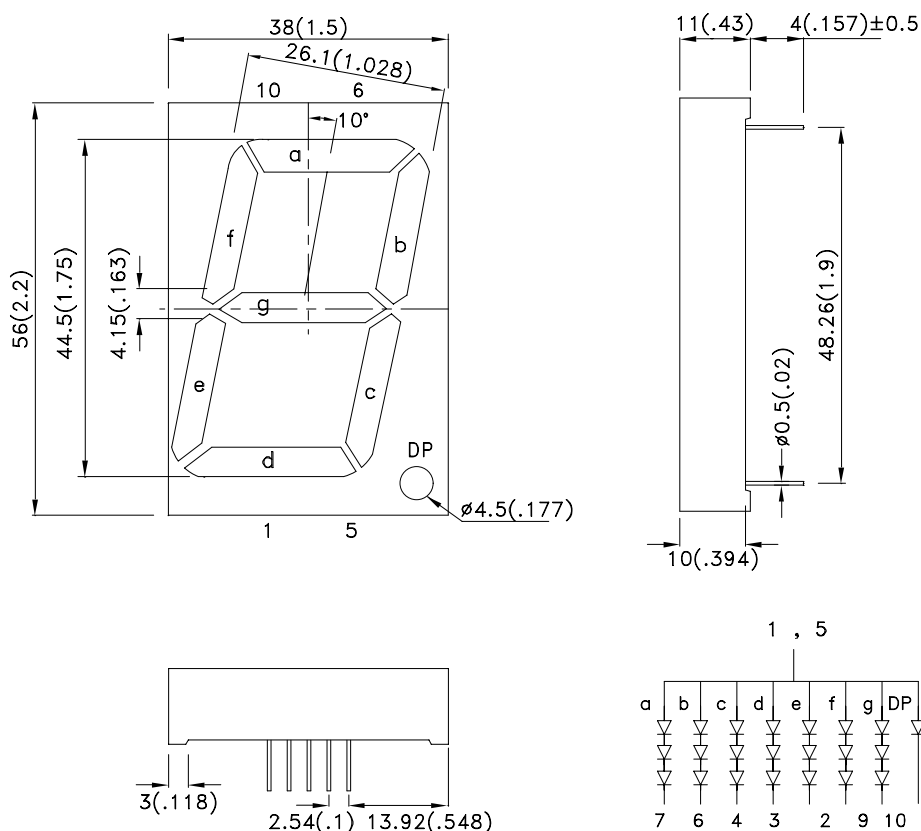
Features

- 1.75 INCH DIGIT HEIGHT.
- LOW CURRENT OPERATION.
- EXCELLENT CHARACTER APPEARANCE.
- EASY MOUNTING ON P.C. BOARDS OR SOCKETS.
- I.C. COMPATIBLE.
- CATEGORIZED FOR LUMINOUS INTENSITY.
- MECHANICALLY RUGGED.
- STANDARD : GRAY FACE, WHITE SEGMENT.
- RoHS COMPLIANT.

Description

The High Efficiency Red source color devices are made with Gallium Arsenide Phosphide on Gallium Phosphide Orange Light Emitting Diode.

Package Dimensions& Internal Circuit Diagram



Notes:

1. All dimensions are in millimeters (inches), Tolerance is $\pm 0.25(0.01)$ unless otherwise noted.
2. Specifications are subject to change without notice.



Selection Guide

Part No.	Dice	Lens Type	Iv (ucd) [1] @ 10mA		Description
			Min.	Typ.	
SA18-11EWA	High Efficiency Red (GaAsP/GaP)	WHITE DIFFUSED	4700	24000	Common Anode ,Rt. Hand Decimal.

Note:

1. Luminous intensity/ luminous Flux: +/-15%.

Electrical / Optical Characteristics at TA=25°C

Symbol	Parameter	Device	Typ.	Max.	Units	Test Conditions
λ_{peak}	Peak Wavelength	High Efficiency Red	627		nm	I _F =20mA
λ_D [1]	Dominant Wavelength	High Efficiency Red	625		nm	I _F =20mA
$\Delta\lambda_{1/2}$	Spectral Line Half-width	High Efficiency Red	45		nm	I _F =20mA
C	Capacitance	High Efficiency Red	15		pF	V _F =0V;f=1MHz
V _F [2]	Forward Voltage Per Segment Or (DP)	High Efficiency Red	6.0 (2.0)	7.5 (2.5)	V	I _F =20mA
I _R	Reverse Current Per Segment Or (DP)	High Efficiency Red		10 (10)	uA	V _R =15V (V _R =5V)

Notes:

1.Wavelength: +/-1nm.

2. Forward Voltage: +/-0.1V.

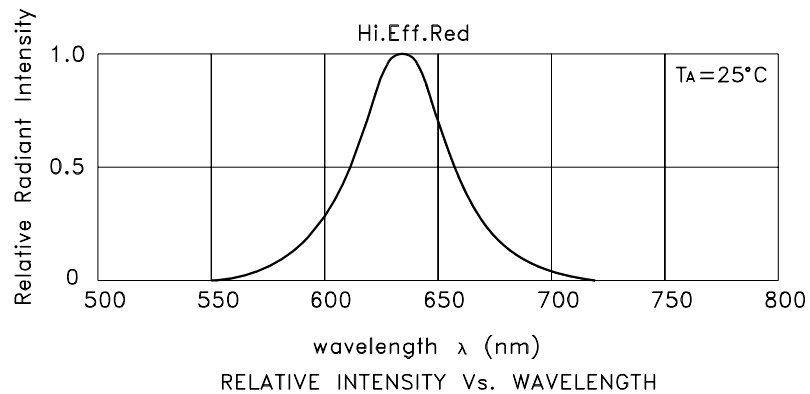
Absolute Maximum Ratings at TA=25°C

Parameter	High Efficiency Red	Units
Power dissipation Per Segment Or (DP)	225 (75)	mW
DC Forward Current Per Segment Or (DP)	30 (30)	mA
Peak Forward Current [1] Per Segment Or (DP)	160 (160)	mA
Reverse Voltage Per Segment Or (DP)	15 (5)	V
Operating / Storage Temperature	-40°C To +85°C	
Lead Solder Temperature[2]	260°C For 3-5 Seconds	

Notes:

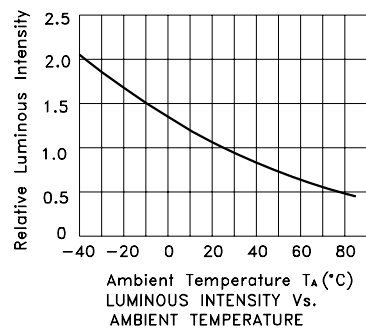
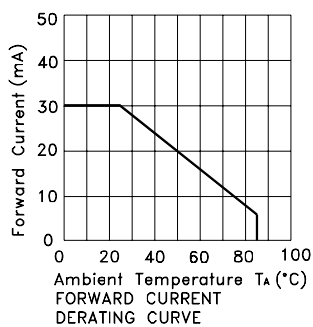
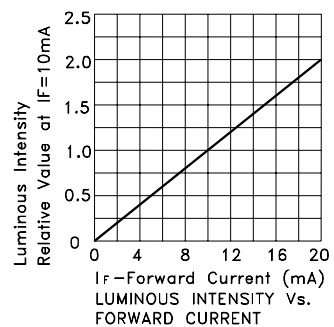
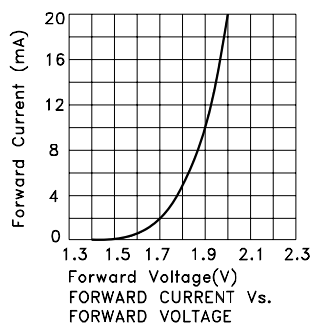
1. 1/10 Duty Cycle, 0.1ms Pulse Width.

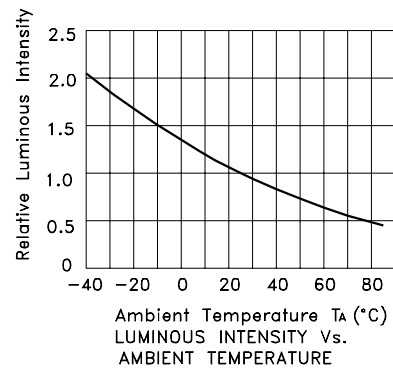
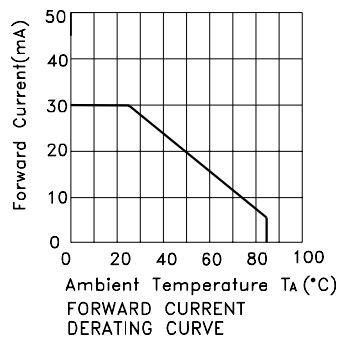
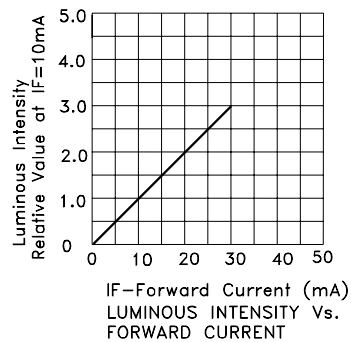
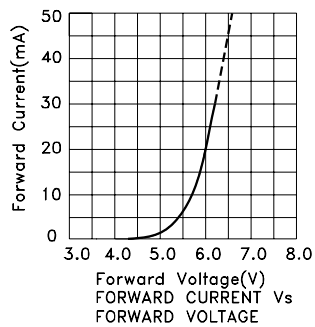
2. 2mm below package base.



High Efficiency Red

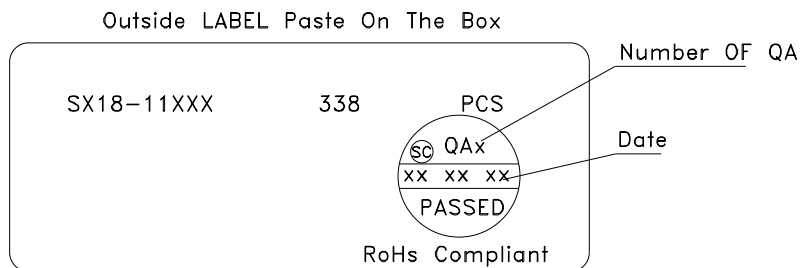
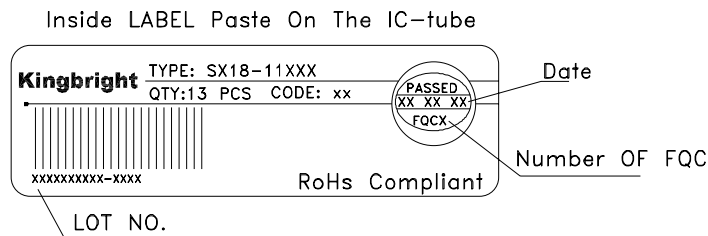
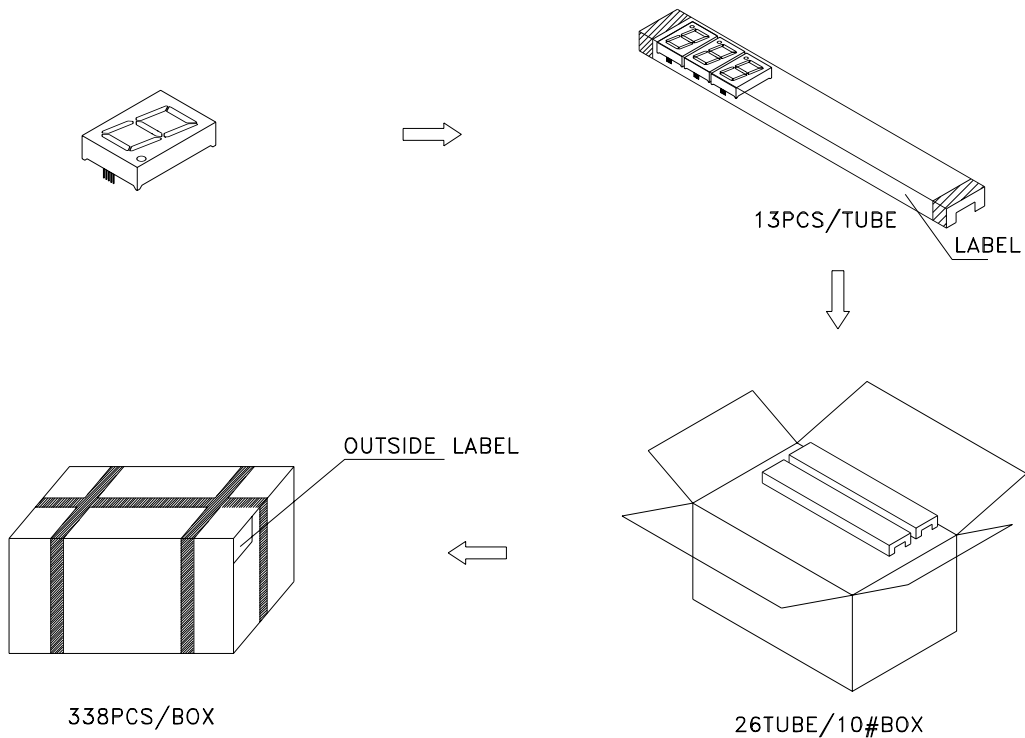
SA18-11EWA





PACKING & LABEL SPECIFICATIONS

SA18-11EWA



Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9